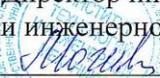


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Институт технологий и инженерной механики  
Кафедра материаловедения  
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор института технологий  
и инженерной механики  
 Могильная Е.П.  
« 18 » 02 2025 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
по учебной дисциплине

**Кристаллохимия фаз и механизмы фазовых превращений**

22.04.01 материаловедение и технологии материалов

Структурные и фазовые превращения при деформационно-термической  
обработке  
Функциональные материалы, покрытия

Разработчик:

доцент  Черников Н. Г.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры материаловедения

от « 18 » 02 20 25 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой материаловедения  Рябичева Л.А.

Луганск 20 25 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине  
«Кристаллохимия фаз и механизмы фазовых превращений»**

**Задания закрытого типа**

**Задания закрытого типа на выбор правильного ответа**

1. В среднюю категорию входит сингония

А) тригональная

Б) тетрагональная

В) гексагональная, тригональная, тетрагональная

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-6

2. Воображаемая точка, находящаяся внутри кристалла, в которой пересекаются и делятся пополам линии, соединяющие одинаковые элементы ограничения кристалла называют

А) ось симметрии

Б) центр симметрии

В) плоскость симметрии

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-6

3. Триклинная сингония имеет следующий вид симметрии

А) планальный, аксиальный

Б) примитивный, центральный

В) планаксиальный

Правильный ответ: Б

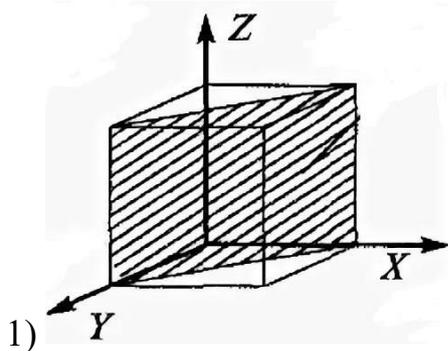
Компетенции (индикаторы): ПК-6

**Задания закрытого типа на установление соответствия**

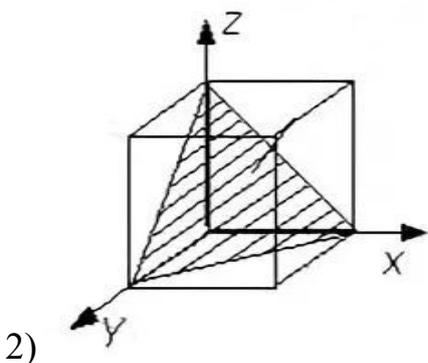
*Установите правильное соответствие.*

*Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.*

1. Укажите параметры плоскости



A) (111)



Б) (101)

Правильный ответ: 1-Б, 2-А

Компетенции (индикаторы): ПК-6

2. Установите соответствие параметров сингонии

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1) тетрагональная | А) $a = b \neq c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$                |
| 2) гексагональная | Б) $a \neq b \neq c; \alpha = \beta = 90^\circ \neq \gamma$          |
| 3) моноклинная    | В) $a = b \neq c; \alpha = \beta = 90^\circ \neq \gamma = 120^\circ$ |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-6

3. Установите соответствие параметров связей

- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 1) ионная        | А) $AlCr_2, CuAl_{11}Fe_4$ |
| 2) металлическая | Б) $(NaCl), (H_2SO_4)$     |
| 3) ковалентные   | В) $(CH_4), (HCl)$         |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Компетенции (индикаторы): ПК-6

### Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

*Установите правильную последовательность.*

*Запишите правильную последовательность букв слева направо*

1. Установите правильную последовательность этапов образования кристаллов.

- А) рост кристаллов
- Б) зарождение центров кристаллизации

В) твёрдая фаза

Г) жидкая фаза

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-6

2. Определите правильную последовательность симметрии структуры кристаллических веществ:

А) определение вида симметрии

Б) запись формулы симметрии

В) определение единичных направлений

Г) определение элементов симметрии

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-6

3. Установите порядок записи формулы симметрии кристалла в обозначениях О. Браве:

А) плоскость симметрии

Б) центр симметрии

В) ось симметрии

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-6

### **Задания открытого типа**

#### **Задания открытого типа на дополнение**

*Напишите пропущенное слово (словосочетание).*

1. Полиморфизм в кристаллохимии – это способность соединений \_\_\_\_\_ химического состава существовать в двух или нескольких модификациях с различным расположением атомов или молекул - различной кристаллической структурой.

Правильный ответ: одинакового, одного

Компетенции (индикаторы): ПК-6

2. Гетерогенное зарождение кристаллов – это процесс \_\_\_\_\_ зародышей на имеющейся межфазной поверхности, например, на поверхности находящихся в расплаве твёрдых частиц (например, неметаллических включений), стенок изложниц и кристаллизаторов.

Правильный ответ: образования, роста

Компетенции (индикаторы): ПК-6

3. Бейнитное превращение - превращение переохлаждённого \_\_\_\_\_ в интервале температур между температурными

интервалами перлитного (диффузионного) и мартенситного (бездиффузионного) превращения, поэтому его иногда называют промежуточным превращением.

Правильный ответ: аустенита

Компетенции (индикаторы): ПК-6

### **Задания открытого типа с кратким свободным ответом**

*Дайте ответ на вопрос*

1. Какой тип химической связи характерен для сталей?

Правильный ответ: металлическая связь

Компетенции (индикаторы): ПК-6

2. Какая сингония относится к высшей категории?

Правильный ответ: кубическая

Компетенции (индикаторы): ПК-6

3. Что является главной особенностью кристаллических структур?

Правильный ответ: закономерная повторяемость в пространстве их узлов, рядов и плоских сеток

Компетенции (индикаторы): ПК-6

### **Задания открытого типа с развернутым ответом**

*Дайте ответ на вопрос*

1. Опишите процесс выращивания искусственных кристаллов.

Время выполнения – 15 мин.

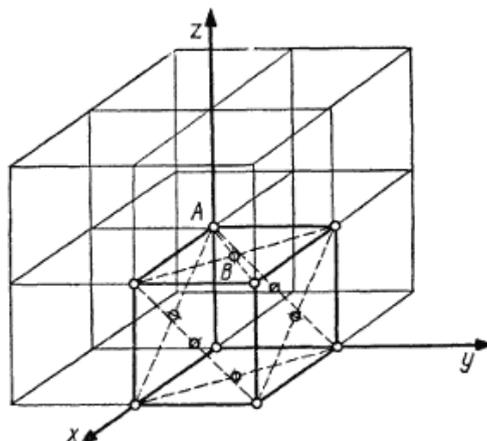
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведённому ниже пояснению: Искусственное выращивание кристаллов - процесс, при котором кристаллы формируются не в естественных условиях, а в специально созданных лабораторных условиях. Это позволяет контролировать процесс и получать кристаллы нужного размера и формы. Существуют несколько методов выращивания искусственных кристаллов: Метод Чохральского. Монокристалл выращивается путём постепенного вытягивания из расплава. При этом температура расплава или постоянна, или меняется по определённому закону. Метод требует определённого технологического оборудования, постоянного контроля температуры и других параметров процесса.

Метод Киропулоса. Применяется для получения массивных монокристаллов, используемых в оптических приборах и других отраслях промышленности. Затравка крепится в водоохлаждаемом кристаллодержателе и контактирует с расплавом, расположенным в тигле.

Метод флюса. В основном применяется для получения тугоплавких веществ, кристаллизация которых из расплава при быстром охлаждении невозможна. В качестве растворителей (флюса) служат расплавы легкоплавких окислов или солей.

Компетенции (индикаторы): ПК-6

2. Определить число  $n$  узлов, приходящихся на одну элементарную ячейку в гранецентрированной кубической решётке.

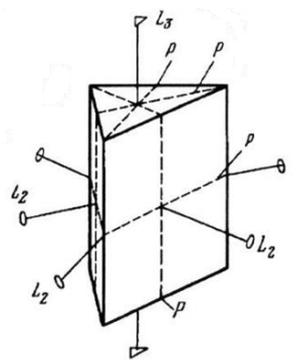


Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведённому ниже пояснению: В кубической гранецентрированной решётке (рис. 49.3) элементарная ячейка содержит узлы двух типов: А (в вершинах куба) и В (в центрах граней). Узел А принадлежит восьми ячейкам и входит в данную ячейку с долей  $1/8$ . Узел В принадлежит двум ячейкам и входит с долей  $1/2$ . Общее число узлов на ячейку составляет 8 (тип А), 6 (тип В). На элементарную ячейку приходится четыре атома:  $n = (1/8) \times 8 + (1/2) \times 6 = 1 + 3 = 4$ .

Компетенции (индикаторы): ПК-6

3. Согласно рисунка напишите формулу симметрии тригональной сингонии и укажите последовательность написания формулы симметрии для различных кристаллов.



Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведённому ниже пояснению: Формула симметрии тригональной сингонии имеет вид -  $L_33L_24P$ . Согласно рисунка тригональная сингония имеет одну ось третьего порядка  $L_3$ , три оси второго порядка  $L_2$ , и четыре плоскости симметрии. При записи формулы симметрии кристаллов вначале записывается количество осей симметрии определённого совмещения, далее указывается ось симметрии от большей к меньшей  $L_6, L_4, L_3, L_2$ . Далее записывает количество плоскостей симметрии и последнее записывается центр симметрии.

Компетенции (индикаторы): ПК-6

### Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Кристаллохимия фаз и механизмы фазовых превращений» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению.

Председатель учебно-методической комиссии  
института технологий и инженерной механики

 Ясуник С.Н.

### **Лист изменений и дополнений**

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)